

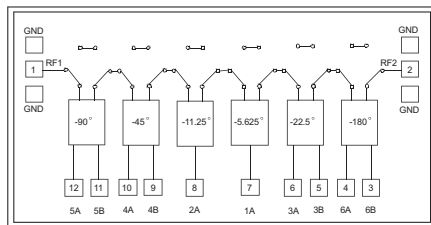
BW326

GaAs单片集成6位数控移相器

性能特点

- 工作频段：1.6~3.2GHz
- 插入损耗：10dB
- 移相精度（RMS）：1.5°
- 插损波动：±0.5dB
- 芯片尺寸：5.00x3.00x0.10mm

功能框图



概述

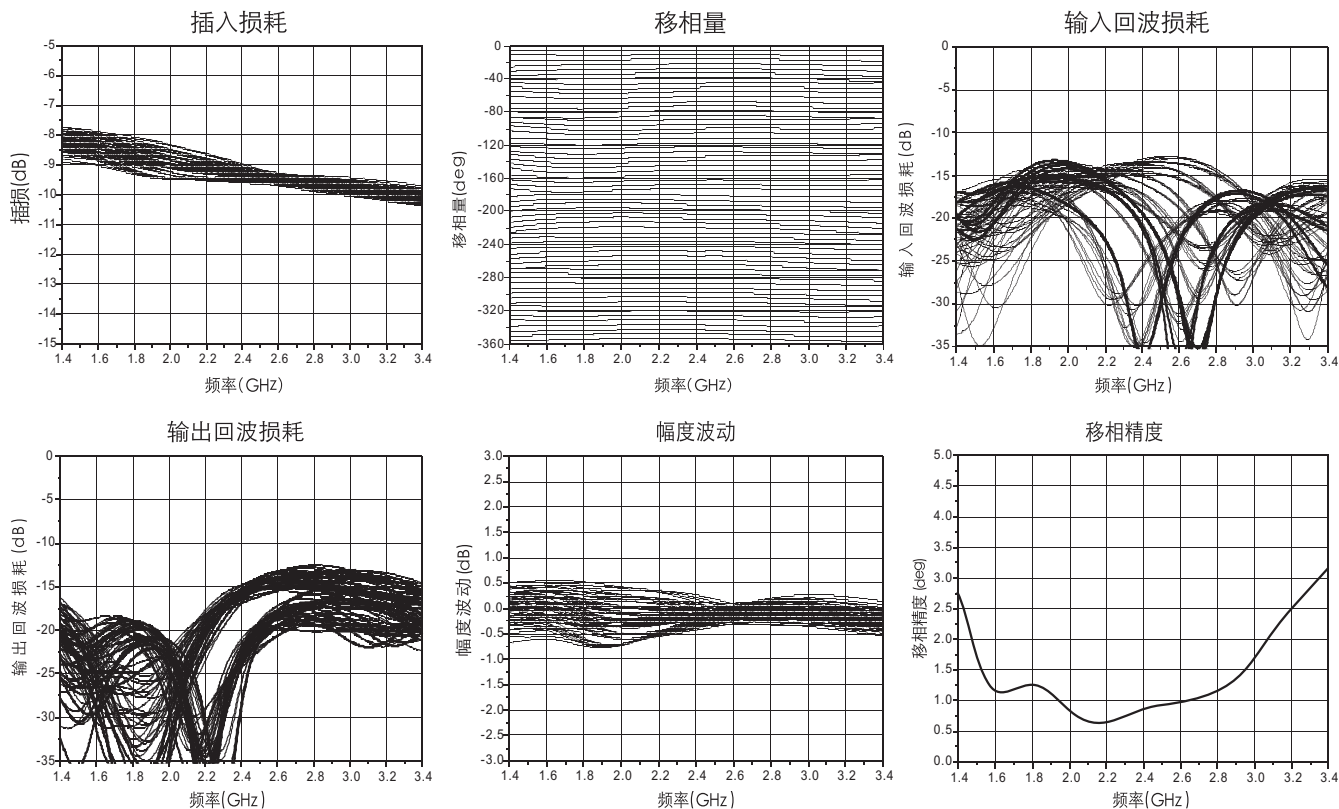
BW326是一款GaAs 6位数控移相器芯片。工作频率1.6~3.2GHz，插入损耗小于10.5 dB，基本移相位为-5.625°、-11.25°、-22.5°、-45°、-90°、-180°，总移相量-354.375°。该芯片采用0/-5V逻辑控制，不需要外接电源偏置，没有功率消耗。在整个工作频率范围内具有优良的移相精度和端口驻波特性，非常适合应用于微波混合集成电路和多芯片模块以及低功耗系统。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好接地,不需要额外的接地措施,使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理,适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

电性能表 (T_A =+25℃, 0/-5V控制, 50Ω system)

参数	频率	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	1.6~3.2GHz	-	10	10.5	dB
幅度波动	1.6~3.2GHz	-	±0.5	±0.8	dB
移相精度 (RMS)	1.6~3.2GHz	-	1.5	2.5	deg
回波损耗 (RF1、RF2)	1.6~3.2GHz	-	15	-	dB
输入P1dB	1.6~3.2GHz	-	21	-	dBm
输入IP3	1.6~3.2GHz	-	35	-	dBm
开关时间	-	-	10	-	ns

测试曲线(射频端口使用两根Φ25um长400um的键合线)



BW326型GaAs单片集成6位数控移相器

极限参数

射频输入功率	+24dBm
控制电压范围(A , B)	+0.5 V ~-7.0V
结 温	175 ℃
储存温度	-65~+150 ℃
工作温度	-55~+125 ℃
静电防护等级 (HBM)	Class1A



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1,2	RF1 , RF2	RF端口, 阻抗50Ohm
4,6,7,8,10,12	CTRL A	控制端口
3,5,9,11	CTRL B	控制端口
-	GND	芯片背面必须接地

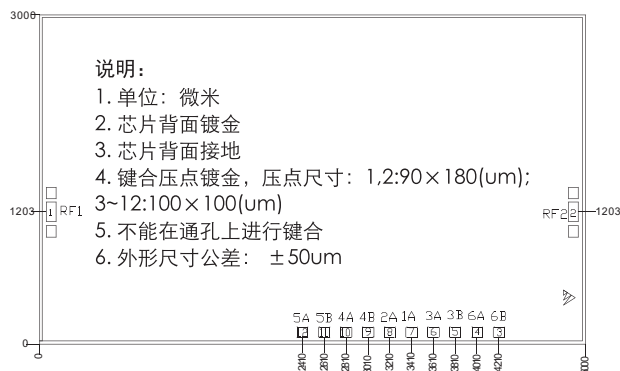
控制电压

状态	偏置条件
低	0 ~ -0.2V
高	-3 ~ -5V

真值表

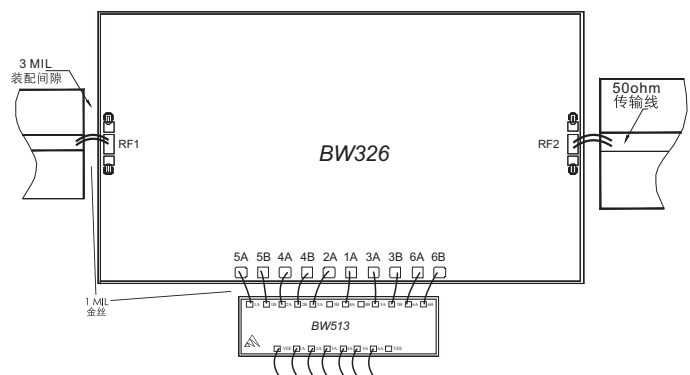
-5.625°	-11.25°	-22.5°		-45°		-90°		-180°		移相状态
1A	2A	3A	3B	4A	4B	5A	5B	6A	6B	
1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	参考态
0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	-5.625°
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	-11.25°
1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	-22.5°
1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	-45°
1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	-90°
1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	-180°

外形尺寸

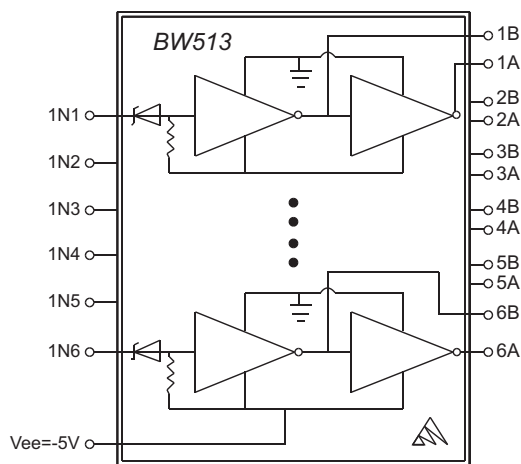


应用信息

- 装配图(射频端口使用两根Φ25um长400um的键合线)



推荐驱动电路



备注: BW513是单片集成6位FET驱动器。